

Jing High-Tech Co., Ltd., Guangdong Province, Guangdong
D13005

NPN bipoláris tranzisztor szilícium

. Fő felhasználási ■ ■: használt elektronikus energiatakarékos lámpák, elektronikus előtéttek és más hatalmi kapcsoló áramkör.

■ ■ maximális abszolút értéke ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

A paraméter neve Symbol Egységek

Értékelése

Kollektor - bázis V_{ce0} feszültség 700 V

Collector - Emitter Voltage V_{ce0} 400 V

-Kibocsátó - alap feszültség V_{EB0} 9 V

Collector jelenlegi I_C 4 A

Base jelenlegi I_B 2 A

($T_c = 25^\circ\text{C}$) 70

Collector PD W

($T_a = 25^\circ\text{C}$)

Power dissipation 2

$^\circ\text{C}$

Junction Temperature T_j 150

B C E

$^\circ\text{C}$

Tárolási hőmérséklet T_{stg} -55-150

■ ■ elektromos paraméter ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

Normatív értékek

A paraméter neve Symbol Vizsgálati feltételek Egységek

Tipikus Minimum Maximum

Meghatározatlan-emitter Egyenáram nyereséget 40β értéke

$HFE(1) V_{ce} = 5\text{V}, I_c = 1.0\text{A}$ 10

Kollektor - bázis bontás feszültség BV_{ce0} $I_c = 1\text{mA}$, azaz $0 = 700\text{V}$

Collector - emitter feszültség bontás BV_{ce0} $I_c = 10\text{mA}$ $I_b = 0$ 400 V

-Kibocsátó - Base Breakdown Voltage BV_{EB0} $I_E = 1\text{mA}$, $I_c = 0$ 9 V

Kollektor - bázis cut-off jelenlegi $V_{CB} = 700\text{V}$, $I_e = 0$

I_{cbo} 1 mA -

-Kibocsátó - base cut-off jelenlegi $V_{EB} = 9\text{V}$, $I_c = 0$

I_{ebo} 1 mA -

Collector - emitter telítettség feszültségesés $V_{ce(sat)}$ $I_C = 2\text{A}$, $I_b = 0,5$ 0,6 0,6 V

Base - emitter telítettség feszültségesés $V_{BE(SAT)}$ $I_C = 2\text{A}$, $I_b = 0,5$ 1,2 1,6 V

Jellemző f_t 4 MHz-es frekvencia

$V_{ce} = 10\text{V}$, $I_c = 500\text{mA}$, $f = 1.0\text{MHz}$

On-time t_{on} μS

0,8

$V_{ce} = 10\text{V}$, $I_c = 2\text{A}$,

Tárolási idő t_s μS

4,0

$I_{B1} = I_{B2} = 400\text{mA}$

Fall Time t_f μS

0,9